

# 2SB793, 2SB793A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

低周波出力増幅用 / AF Power Amplifier

2SD973, 2SD973A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SD973, 2SD973A

## ■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。 / Low  $V_{CE(sat)}$
- M 型パッケージで自動挿入、手挿入が容易、P 板に自立固定できる。  
M type package suitable for automatic insertion, for easier manual insertion, self-standing on PC board.

## ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	-30	V
2SB793A		-60	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	-25	V
2SB793A		-50	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	-5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	-1.5	A
コレクタ電流	$I_C$	-1	A
コレクタ損失	$P_C^*$	1	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

\*プリント基板：コレクタ部分の銅箔面積  $1\text{cm}^2$  以上、厚み  $1.7\text{mm}$

Copper plate at the collector is more than  $1\text{cm}^2$  in area,  $1.7\text{mm}$  in thickness.

## ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -20\text{V}, I_E = 0$			-0.1	$\mu\text{A}$
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$	-30			V
			-60			
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C = -2\text{mA}, I_E = 0$	-25			V
			-50			
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$	-5			V
直流電流増幅率	$h_{FE1}^{*1}$	$V_{CE} = -10\text{V}, I_C = -500\text{mA}^{*2}$	85		340	
	$h_{FE2}$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}^{*2}$	50			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$			-0.4	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$			-1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 50\text{mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$		20	30	pF

\*2 パルス測定 / Pulse Test

### \*1 $h_{FE1}$ ランク分類 / $h_{FE1}$ Classifications

Class	Q	R	S
$h_{FE1}$	85 ~ 170	120 ~ 240	170 ~ 340

